

## Лабораторная работа 5.10.1 Электронный парамагнитный резонанс

# Студенты:

Панченко Наталья
Исламов Сардор
Физтех-школа физики и исследований им. Ландау
Московский Физико-Технический Институт

**Аннотация.** В работе исследован электронный парамагнитный резонанс. Определен g-фактор электрона, измерена ширина линии ЭПР.

#### Теоретическое введение

Энергетический уровень электрона в присутствии магнитного поля с индукцией В расщепляется на подуровни, расстояние между которыми равно

$$\Delta E = E_2 - E_1 = 2\mu B \tag{1}$$

где  $\mu$  – абсолютная величина проекции магнитного момента на направление поля. Электрон может переходить между уровнями, будучи возбужденным внешним магнитным полем, если оно имеет нужную частоту и направление. Резонансное значение частоты определяется по формуле:

$$\Delta E = \hbar \omega_0 \tag{2}$$

При переходе с нижнего на верхний уровень энергии электрон поглощает квант электромагнитной энергии, а при обратном переходе такой же квант излучается. Возбуждение электронных переходов электромагнитным полем, имеющим частоту, определяемую формулой (2),носит название электронного парамагнитного резонанса (ЭПР). Другими словами ЭПР происходит из-за переворота спина электронов (только неспаренные) под действием высокочастотного электромагнитног поля. В настоящей работе необходимо получить сигнал ЭПР на кристаллическом дифенилпикрил- гидразиле (ДФПГ) и определить значение g-фактора для электрона. Как известно, связь между магнитным моментом  $\mu$  электрона и его механическим моментом M выражается через гиромагнитное отношение  $\gamma$  с помощью формулы:

$$\mu = \gamma M \tag{3}$$

Если магнитный момент частицы, измеренный в магнитонах Бора, а механический - в  $\hbar$ , то их связь можно записать через q-фактор:

$$\frac{\mu}{\mu_B} = \frac{gM}{\hbar} \tag{4}$$

Эта формула справедлива для соответсвующих проекций  $\mu$  и M на любое выбранное направление:

$$\frac{\mu}{\mu_B} = \frac{Sg\hbar}{\hbar} \tag{5}$$

где  $S=\frac{1}{2}$  - спин электрона. Используя соотношения (1)-(5), получим выражение для g-фактора через определяемые экспериментально величины:

$$g = \frac{h\nu}{\mu_B B} \tag{6}$$

#### Экспериментальная установка

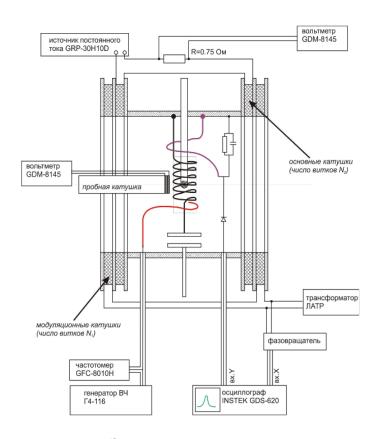


Рис. 1: Экспериментальная установка

Образец (порошок ДФПГ) в стеклянной ампуле помещяется внутрь катушки индуктивности, которая вместе с конденсатором образует колебательный контур. Конденсатор состоит из двух пластин, разделенных воздушным зазором. Изменять ёмкость конденсатора можно увеличия воздушный зазор с помощью поворта штока. Колебания в контуре возбуждаются антенной, соединённой с генератором частоты (ВЧ) Г4-116. Амплитуда колебаний поля в катушке индуктивности измеряется по наводимой в петле связи ЭДС индукции. Высокочастотные колебания ЭДС индукции в приёмном контуре детектируются диодом, измеряемая при помощи осциллографа низкочастотная огибающая этого сигнала пропорциональна квадрату амплитуды колебаний поля в катушке. Постоянной магнитное поле создаётся пропусканием тока от источника постоянного тока через основные катушки. При этом при помощи вольтметра измеряется падение напряжения на резисторе в цепи основных катушек. Переменное поле небольшой амплитуды создаётся подачей на модуляционные катушки напряжения с регулируемого трансформатора ЛАТР. Для измерения амплитуды колебаний переменного поля используется пробная катушка известной геометрии, подключенная к вольтметру.

### Обработка результатов

**Калибровка.** Установим зависимость между показаниями вольтметров, чтобы далее из значений напряжения получить величину магнитной индукции (рис. 2)

| $V_R$ , мВ | 54,1 | 61  | 67  | 73,5 | 80,5 | 90,3 |
|------------|------|-----|-----|------|------|------|
| V, мВ      | 6,7  | 7,5 | 8,3 | 9,15 | 10   | 11,2 |

Таблица 1: Калибровка

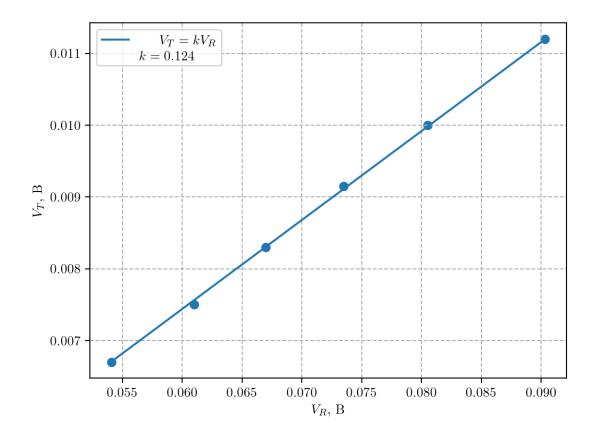


Рис. 2: Калибровка

**Ход работы.** Будем изменять ёмкость конденсатора и искать новые значения частот на резонансе:

| Частота,МГц | V слева, мВ | V центр, мВ | V справа, мВ |
|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 147,8       | 113,2       | 107,6       | 102,6        |
| 80,2        | 65,5        | 58,9        | 54,6         |
| 100,4       | 76,4        | 71,2        | 63,6         |
| 110,6       | 86,4        | 81,3        | 76,2         |
| 117,3       | 91,3        | 86,1        | 80,5         |
| 131,4       | 101,8       | 96,5        | 90,9         |
| 144,3       | 110,9       | 105,5       | 100,4        |
| 151         | 116,4       | 110,9       | 105,6        |

Таблица 2: Напряжение от частоты

Запишем параметры катушек в таблицу 2:

| Катушка       | Количество витков | Диаметр, м |  |
|---------------|-------------------|------------|--|
| Основная      | 5500              | 0,25       |  |
| Модуляционная | 1500              | 0,3        |  |
| Пробная       | 49                | 14,3       |  |

Таблица 3: параметры катушек

По формуле

$$B = \frac{4kV_R}{2\pi\nu N_{\rm npo6}\pi d_{\rm npo6}^2},$$

где k — коэффицент наклона из рис. 2,  $\nu = 50$  — частота модуляционного напряжения, получим значения магнитной индукции и построим ее зависимость от частоты (рис. 3)

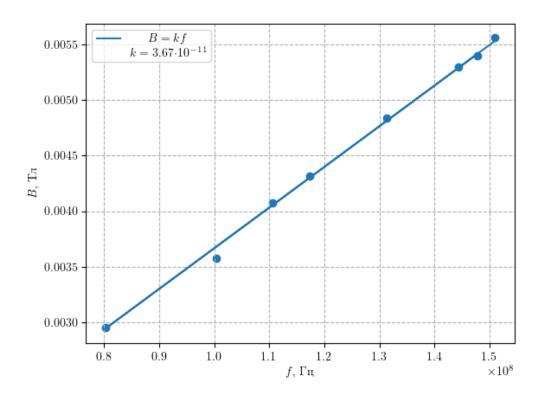


Рис. 3: Зависимость  $B(\nu)$ 

Из коэффицинета наклона  $k_2 = (3.67 \pm 0.11) \cdot 10^{-11}$  получим значение g по формуле

$$g = \frac{hf}{\mu_{\rm B}B} = \frac{h}{\mu_{\rm B}k_2} = 1.95 \pm 0.1$$

Ширина ЭПР. Рассчитаем ширину ЭПР на полувысоте пика.

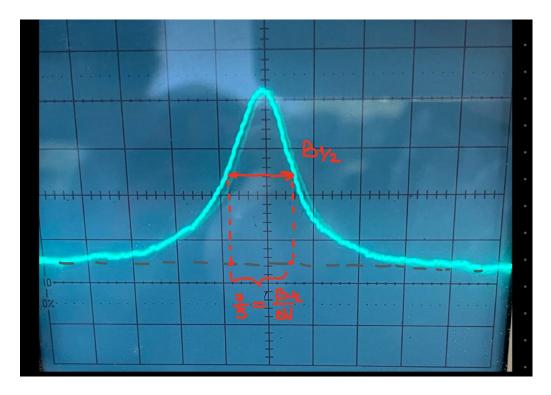


Рис. 4: Ширина ЭПР

где  $B_{\frac{1}{2}}\sim \frac{7\Delta V}{5}$ , где  $\Delta V=5,3$  мВ - ширина клетки (считаем для частоты 131,4 МГц).  $\Rightarrow \Delta B_{\frac{1}{2}}=0,37\pm0,1$  мТл

### Выводы

В результате работы было исследовано явление электронного парамагнитного резонанса в молекуле ДФПГ. Был найдет g-фактор электрона:  $g=1.95\pm0.1$ , что в пределах погрешности совпадает с теоретическим значением g=2. Также была определена ширина линии ЭПР  $\Delta B_{1/2}=0.37\pm0.1$  мТл.